



(12) **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(43) Date de publication:  
30.05.2001 Bulletin 2001/22

(51) Int Cl.<sup>7</sup>: **G03F 7/20, H01L 23/525,  
H01L 21/033**

(21) Numéro de dépôt: 01104110.0

(22) Date de dépôt: 14.05.1999

(84) Etats contractants désignés:  
**DE FR GB IT**

• **Revil, Nathalie, Cabinet Ballot**  
83000 Toulon (FR)

(30) Priorité: 14.05.1998 **FR 9806071**

(74) Mandataire: **Ballot, Paul Denis Jacques**  
**Cabinet Ballot**  
9, boulevard de Strasbourg  
83000 Toulon (FR)

(62) Numéro(s) de document de la (des) demande(s)  
initiale(s) en application de l'article 76 CBE:  
99401181.5 / 0 957 403

(71) Demandeur: **STMicroelectronics S.A.**  
94250 Gentilly (FR)

Remarques:

Cette demande a été déposée le 21 - 02 - 2001  
comme demande divisionnaire de la demande  
mentionnée sous le code INID 62.

(72) Inventeurs:  
• **Delpech, Philippe, Cabinet Ballot**  
83000 Toulon (FR)

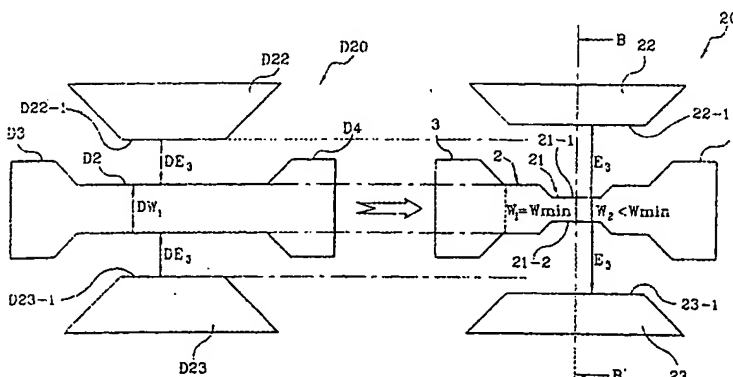
(54) **Procédé de réalisation par photolithographie de fusible de circuit intégré à point de claquage localisé**

(57) L'invention concerne un procédé de réalisation par photolithographie de circuit intégré disposant d'au moins un fusible (20) comprenant des plages (3,4) comportant des contacts électriques et une région centrale (2) sensiblement en forme de barreau comportant une région amincie (21) formant un point faible facilitant le claquage du fusible par augmentation de la densité de courant dans des conditions standards de claquage.

Le procédé consiste à :

- former un masque d'insolation reproduisant un des-

sin de fusible comportant la région centrale en forme de barreau, en disposant au moins un élément factice (22) à proximité de la région centrale, et  
- former, par insolation à travers le masque d'insolation, un masque de gravure de fusible dont la région centrale fait apparaître une zone amincie par effet optique de proximité, de sorte que la largeur ( $W_2$ ) de la zone amincie est inférieure à un minimum technologique ( $W_{min}$ ) déterminé par la technologie de fabrication du circuit intégré.



**FIG. 7**

**FIG. 8**

## Description

[0001] La présente invention concerne le domaine des circuits intégrés et plus particulièrement un fusible de circuit intégré.

[0002] La prévision de fusibles dans les circuits intégrés est une pratique courante pour l'homme de l'art, notamment dans le cadre de la fabrication des circuits MOS. Par exemple, il est classique de prévoir des fusibles pour protéger des grilles de transistors MOS contre l'accumulation de charges électrostatiques apparaissant pendant la fabrication des circuits intégrés. Ces fusibles sont ensuite claqués pour libérer les grilles des transistors. Comme autre exemple, la prévision de lignes de mots ou de lignes de bits redondantes dans les mémoires à grande capacité repose également sur l'utilisation de fusibles, les lignes défectueuses ou inutilement redondantes étant ensuite isolées du reste de la mémoire par claquage de fusibles.

[0003] Ainsi, de façon générale, les fusibles présents dans les circuits intégrés sont destinés à être grillés par application d'une tension ou d'un courant de claquage, et permettent de modifier la configuration d'un circuit à un stade final de fabrication.

[0004] La présente invention concerne plus particulièrement un fusible réalisé par gravure, du type représenté sur la figure 1. Un tel fusible 1, d'une structure très simple et d'un faible encombrement, comprend une région centrale 2 en forme de barreau s'épanouissant à ses extrémités pour former deux plages 3, 4 recevant une pluralité de contacts électriques 5, 6. En général, comme représenté sur la figure 2 par une vue en coupe, le fusible 1 est enterré dans un circuit intégré 10 où il se trouve pris en sandwich entre une couche inférieure 11 et une couche supérieure 12 d'oxyde déposées sur un substrat de silicium 13. Les contacts 5, 6 prennent la forme d'orifices métallisés traversant la couche d'oxyde 12 pour relier les plages 3, 4 à des conducteurs 14, 15. Classiquement, l'ensemble est réalisé par dépôt successif de diverses couches d'oxyde, de métal et/ou de polysilicium et gravure des couches par photolithographie.

[0005] Afin que la densité de courant dans le fusible 1 et l'efficacité du claquage soient maximales pour un courant de claquage donné, il est d'usage que la largeur  $W$  de la région centrale 2 du fusible soit choisie égale au minimum technologique  $W_{\min}$  autorisé par la technologie de fabrication du circuit intégré 10. A titre d'exemple, il est courant à l'heure actuelle que le minimum technologique  $W_{\min}$  des circuits intégrés de type MOS soit de l'ordre de 0,25 micromètre en ce qui concerne la largeur minimale d'un conducteur (soit la longueur minimale des grilles des transistors MOS).

[0006] Cette précaution ne représente toutefois qu'un avantage relatif étant donné que le minimum technologique détermine également la taille des autres composants présents dans le circuit intégré 10, notamment des transistors, et leur capacité à résister aux tensions

ou aux courants élevés. Ainsi, ces dernières années, la diminution du minimum technologique grâce au perfectionnement des technologies est allée de pair avec une diminution des tensions et courants de claquage admissibles. A titre d'exemple, les tensions de claquage maximales autorisées dans les circuits MOS à moyenne intégration de technologie ancienne sont de l'ordre de 5,5 à 6 Volt et ne sont plus que de 1,8 à 2 Volt avec les circuits à forte intégration de dernière génération.

[0007] Ainsi, malgré la prévision d'une largeur minimale, un fusible classique n'offre pas, statistiquement, un rendement de claquage égal à 100 % dans des conditions standard de claquage. En d'autres termes, lorsque l'on cherche à claquer simultanément un ensemble de fusibles présents dans un circuit intégré en appliquant une ou plusieurs impulsions de claquage, de courant ou de tension, il est fréquent qu'il subsiste des fusibles non claqués. Ces fusibles présentent une résistance électrique qui, bien que plus élevée que leur résistance électrique initiale, n'est pas assimilable à un circuit ouvert.

[0008] Il va de soi que cet inconvénient se répercute sur le rendement de fabrication des circuits intégrés et devient rédhibitoire lorsque l'on prévoit dans un même circuit intégré plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de fusibles.

[0009] Le minimum technologique  $W_{\min}$  représente donc un obstacle dans la recherche d'un fusible présentant un bon rendement de claquage. Il est connu dans le domaine de la photolithographie que le minimum technologique  $W_{\min}$  est déterminé par diverses contraintes technologiques, notamment l'obtention d'une fiabilité satisfaisante des grilles des transistors MOS et par ailleurs un phénomène de diffraction et de réflexion de lumière au moment de l'insolation des masques de gravure en résine organique, appelé par l'homme de l'art "effet optique de proximité".

[0010] Enfin, un autre inconvénient des fusibles classiques est de n'être pas entièrement fiables, un certain pourcentage de fusibles claqués ayant tendance à se régénérer, pour des raisons encore mal expliquées. En pratique, la régénération d'un fusible se traduit par le fait que ses propriétés d'isolement électrique se dégradent alors qu'elles étaient initialement satisfaisantes.

[0011] Ainsi, un objectif général de la présente invention est de prévoir un fusible de circuit intégré qui soit susceptible de claquer plus facilement qu'un fusible classique de même encombrement traversé par un courant identique.

[0012] Un autre objectif de la présente invention est de prévoir un fusible offrant un rendement de claquage supérieur aux fusibles classiques et une meilleure fiabilité.

[0013] Un objectif plus particulier de la présente invention est de prévoir un fusible de circuit intégré d'une largeur inférieure à un minimum technologique, et un procédé de fabrication d'un tel fusible.

[0014] Ces objectifs sont atteints par la prévision d'un

fusible de circuit intégré comprenant une région centrale sensiblement en forme de barreau et des plages comportant des contacts électriques, dans lequel la région centrale comporte une zone amincie de moindre largeur formant un point faible facilitant le claquage du fusible par augmentation de la densité locale de courant dans des conditions standard de claquage.

[0015] Avantageusement, le fusible est réalisé par photolithographie et comprend au moins un élément factice à proximité de la zone amincie, l'amincissement de la région centrale étant obtenu par effet optique de proximité entre au moins un bord de la région centrale et un bord de l'élément factice.

[0016] Avantageusement, la largeur de la zone amincie est inférieure à un minimum technologique caractérisant la technologie de fabrication du circuit intégré.

[0017] Avantageusement, la largeur de la région centrale en dehors de la zone amincie est sensiblement égale au minimum technologique.

[0018] Selon un mode de réalisation, la zone amincie est sensiblement symétrique au regard de l'axe longitudinal de la région centrale et est formée par deux encoches pratiquées sur les flancs de la région centrale.

[0019] Selon un mode de réalisation, le fusible comporte deux éléments factices de part et d'autre de la zone amincie.

[0020] Selon un mode de réalisation, le fusible est réalisé en polysilicium siliciuré.

[0021] Selon un mode de réalisation, le fusible comprend des espaceurs d'oxyde ne recouvrant pas entièrement les flancs de la zone amincie.

[0022] Selon un mode de réalisation, les contacts sont des orifices métallisés traversant une couche d'oxyde recouvrant le fusible pour relier les plages du fusible à des éléments conducteurs.

[0023] Selon un mode de réalisation, l'augmentation de la résistance électrique de la région centrale due à la prévision de la zone amincie est négligeable devant la résistance totale du fusible, la résistance totale comprenant une résistance d'accès au fusible, la résistance d'accès comprenant la résistance électrique d'éléments conducteurs et la résistance électrique des contacts.

[0024] Ces objets, caractéristiques et avantages ainsi que d'autres de la présente invention seront exposés plus en détail dans la description suivante d'un exemple de réalisation d'un fusible selon l'invention et d'un procédé permettant de réaliser un tel fusible, faite à titre non limitatif en relation avec les figures jointes parmi lesquelles :

- la figure 1 précédemment décrite est une vue de dessus d'un fusible classique,
- la figure 2 précédemment décrite est une vue en coupe selon un axe AA' du fusible de la figure 1 agencé dans un circuit intégré,
- la figure 3 est une vue de dessus d'un fusible selon l'invention,
- la figure 4 est le schéma électrique équivalent du

fusible de la figure 3,

- les figures 5A à 5C représentent des étapes classiques de photolithographie, allant de la conception à la réalisation d'une gravure à la surface d'un circuit intégré,
- les figures 6A à 6C représentent pour une gravure de moindre largeur les mêmes étapes que les figures 5A à 5C et illustrent un phénomène appelé "effet optique de proximité",
- la figure 7 représente le dessin initial d'un fusible selon l'invention,
- la figure 8 représente le fusible obtenu à partir du dessin de la figure 7, et
- la figure 9 est une vue partielle en coupe selon un axe BB' du fusible de la figure 8 agencé dans un circuit intégré.

[0025] La figure 3 représente par une vue de dessus un fusible 20 selon la présente invention. Dans sa forme générale, le fusible 20 a l'aspect du fusible classique de la figure 1. Le fusible 20 comporte ainsi une région centrale 2 sensiblement en forme de barreau, ici d'une longueur L égale au triple de sa largeur W1, et des plages 3, 4 pourvues de contacts 5, 6, les références de ces divers éléments étant conservées. Le fusible 20 est réalisé par gravure d'une couche mince de polysilicium, de métal ou d'alliage, ou encore par gravure d'une couche mince formée d'un empilement de métaux ou d'alliages.

[0026] Selon l'invention, la région centrale 2 du fusible 20 présente un rétrécissement, ou zone amincie 21, de largeur W2 inférieure à la largeur moyenne W1 de la région centrale. La largeur W2 est par exemple égale à la moitié de la largeur W1, comme représenté sur la figure 3. La zone amincie 21 occupe une faible partie de la longueur L de la région centrale 2, par exemple un tiers de la longueur L, et est de préférence agencée à mi-distance des plages 3, 4.

[0027] Avantageusement, la zone amincie 21 présente une forte densité de courant dans des conditions standard de claquage, par exemple pour un courant de claquage donné, et forme un point faible facilitant le claquage du fusible. Plus particulièrement, la forte concentration de courant rend le claquage plus explosif et plus efficace, et le fusible selon l'invention offre un meilleur rendement de claquage et une probabilité de régénération plus faible qu'un fusible classique.

[0028] La zone amincie 21 permet par ailleurs de localiser le point d'éclatement du fusible et d'éloigner ce point des plages 5, 6 où se trouve une plus grande quantité de matière conductrice. Selon la demanderesse, et sous réserve d'études complémentaires devant être conduites sur les mécanismes de régénération des fusibles, cet aspect de l'invention est susceptible de contribuer à l'obtention d'une faible probabilité de régénération du fusible et par conséquent d'améliorer sa fiabilité.

[0029] De plus, la résistance électrique totale Rt du fusible n'est pas augmentée de façon significative par

rapport à un fusible de l'art antérieur de même dimension, de sorte que l'on bénéficie d'un même courant de claquage pour une tension de claquage donnée (ou inversement). Cet avantage repose sur le fait qu'en pratique la résistance totale du fusible, c'est-à-dire la résistance mesurable depuis les plots externes d'un circuit intégré, est égale à la somme de la résistance de la région centrale 2 et d'une résistance d'accès au fusible qui n'est pas négligeable. A titre d'exemple numérique, la résistance de la région centrale d'un fusible est classiquement de l'ordre de 1 à 10  $\Omega$ , selon la forme du fusible et les matériaux utilisés, alors que la résistance d'accès, comprenant la résistance de conducteurs menant au fusible et la résistance des contacts 5, 6, est de l'ordre de 11  $\Omega$ .

[0030] Ainsi, comme représenté en figure 4, la résistance électrique totale  $R_t$  du fusible 20 peut être considérée comme égale à la somme de cinq résistances  $R_{a1}$ ,  $R_{a2}$ ,  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$  en série traversées par un courant de claquage  $I_c$ . Les résistances  $R_1$ ,  $R_3$  représentent la résistance de la région centrale 2 de part et d'autre de la zone amincie 21 et sont ici sensiblement égales à la résistance  $R_{\square}$  par unité de surface du matériau constituant le fusible. La résistance  $R_2$  représente la résistance de la zone amincie 21 et est ici sensiblement égale à  $2R_{\square}$ . Les résistances  $R_{a1}$  et  $R_{a2}$  sont les résistances d'accès aux deux extrémités du fusible. La résistance totale  $R_t$  du fusible 20 est ainsi égale à :

$$R_{a1} + R_{a2} + 4 R_{\square}$$

alors que la résistance totale d'un fusible classique de même forme et dimension est égale à :

$$R_{a1} + R_{a2} + 3 R_{\square}$$

La résistance  $R_{\square}$  étant généralement faible devant la résistance d'accès  $R_a$ , il vient que le rapport  $I_c/V_c$  entre courant  $I_c$  et tension  $V_c$  de claquage n'est sensiblement pas modifié par la prévision de la zone amincie 21.

[0031] Par ailleurs, selon un autre aspect de l'invention, on propose de diminuer la largeur  $W_2$  de la zone amincie 21 en dessous d'un minimum technologique  $W_{min}$ , en tirant profit du phénomène appelé effet optique de proximité intervenant dans les procédés de gravure par photolithographie. On va tout d'abord rappeler, pour fixer les idées, comment ce phénomène se manifeste au cours d'un processus de gravure.

[0032] La figure 5C est une vue partielle d'une gravure 30 à bords parallèles, de largeur  $E_1$ , réalisée par exemple dans une couche de polysilicium 31. La figure 5A représente le dessin initial de cette gravure, tel que prévu par un concepteur de circuit intégré, les références de la figure 5C étant précédées de la lettre "D" sur la figure 5A.

[0033] Dans cet exemple, on considère que la largeur

DE1 de la gravure D30 telle que dessinée est choisie supérieure à un seuil technologique  $SE_{min}$ . Ce seuil technologique représente l'espace minimum entre deux éléments en dessous duquel se manifeste l'effet optique de proximité.

[0034] L'étape de dessin illustrée par la figure 5A est suivie de diverses étapes classiques comme la réalisation d'un masque d'insolation reproduisant le dessin initial et la réalisation d'un masque de gravure. La figure 5B représente le masque de gravure 32 correspondant au dessin de la figure 5A. Le masque 32 est obtenu par dépôt d'une couche de résine photosensible sur la couche de polysilicium 31, suivi d'une étape d'insolation de la résine par l'intermédiaire du masque d'insolation, et d'une étape de retrait de la résine insolée au moyen d'un solvant. Au final, le masque 31 présente une ouverture 33 qui laisse apparaître le polysilicium 31, dont la largeur ME1 est égale à la largeur DE1 prévue sur le dessin initial. Après l'étape de gravure du polysilicium, en général une gravure au plasma, la largeur  $E_1$  de la zone gravée 30 (fig. 5C) est elle aussi égale à la largeur prévue DE1 (en pratique, la zone gravée représente l'espace entre deux lignes de polysilicium).

[0035] Les figures 6A à 6C représentent avec les mêmes références les mêmes étapes de processus, la largeur dessinée DE2 de la gravure D30 étant maintenant choisie inférieure au seuil technologique  $SE_{min}$ . Comme on le voit en figure 6B, il en résulte que le masque de gravure 32 présente une ouverture 33 plus importante que prévu, de largeur ME2 supérieure à la largeur DE2 prévue sur le dessin. Ainsi, sur la figure 6C, la gravure 30 présente également une largeur  $E_2$  supérieure à celle prévue sur le dessin.

[0036] Comme cela est bien connu de l'homme de l'art, cet élargissement est principalement dû à des phénomènes de réfraction et de réflexion de lumière au moment de l'insolation du masque de gravure, et marque les limites d'une technologie donnée. Bien entendu, l'effet optique de proximité se manifeste également lorsque l'on veut réaliser une bande étroite de matière par gravure de la matière environnante, ce qui définit un seuil technologique  $SW_{min}$  en largeur d'élément, en dessous duquel les dimensions dessinées sont altérées. Par ailleurs, en relation avec d'autres contraintes technologiques comme la fiabilité des circuits intégrés, l'effet optique de proximité détermine également un minimum technologique  $E_{min}$  en largeur de gravure (espace minimum entre deux éléments) ainsi qu'un minimum technologique  $W_{min}$  en largeur d'élément (largeur minimum d'un élément), déjà cité au préambule. Les minima technologiques  $W_{min}$ ,  $E_{min}$  sont généralement inférieurs aux seuils technologiques  $SW_{min}$ ,  $SE_{min}$  et sont obtenus grâce à des corrections de dessin visant à compenser l'effet optique de proximité.

[0037] On se reportera maintenant aux figures 7 et 8 qui illustrent un procédé selon l'invention permettant de réaliser un fusible 20 ayant une zone amincie 21 de largeur  $W_2$  inférieure au minimum technologique  $W_{min}$ .

[0038] La figure 7 représente le dessin D20 du fusible 20 selon l'invention et la figure 8 représente le fusible 20 obtenu après gravure d'une couche de polysilicium, de métal ou d'alliage, les références de la figure 8 étant précédées de la lettre "D" sur la figure 7. Selon l'invention, le fusible D20 tel que dessiné ne comprend pas de zone amincie mais comporte de part et d'autre de la région centrale D21 deux éléments factices D22, D23 polygonaux. Chaque élément factice D22, D23 présente un bord D22-1, D23-1 parallèle à la région centrale D2, à une distance DE3 de celle-ci. La distance DE3 est volontairement inférieure au seuil technologique  $SE_{min}$  décrit plus haut. Par ailleurs, de préférence, la largeur DW1 de la région centrale D2 est choisie pour obtenir une largeur de fusible égale au minimum technologique  $W_{min}$ .

[0039] Comme on le voit en figure 8, le résultat final après gravure est que la distance E3 entre les bords 22-1, 23-1 des éléments factices et les bords de la région centrale 2 est augmentée par effet optique de proximité, de sorte que l'on a perdu un peu de matière sur les éléments factices 22, 23 et un peu de matière sur les bords de la région centrale 2 en regard des éléments factices 22, 23. La matière enlevée sur les bords de la région centrale 2 forme deux encoches symétriques 21-1, 21-2 faisant apparaître la zone amincie 21, dont la largeur W2 est inférieure au minimum technologique  $W_{min}$ .

[0040] En repoussant ainsi les limites imposées par la technologie, on augmente de façon encore plus sensible la densité du courant de claquage dans la zone amincie, et par conséquent le rendement de claquage et la fiabilité du fusible selon l'invention.

[0041] On va maintenant décrire en relation avec la figure 9 un autre avantage de ce mode de réalisation de l'invention, apparaissant lorsque le fusible est réalisé à partir d'une couche de polysilicium gravée au plasma. On rappelle ici que le polysilicium, même dopé, présente une conductivité médiocre, de sorte qu'il est nécessaire de prévoir un étape de siliciuration en présence d'un métal comme du titane Ti, du Cobalt Co, du Tungstène W, du Tantale Ta... Cette étape permet de déposer à la surface du polysilicium une couche de siliciure, par exemple du siliciure de titane  $TiSi_2$ , diminuant fortement la résistivité électrique du polysilicium.

[0042] La figure 9 est une vue partielle d'un circuit intégré 40 comprenant le fusible 20, vu en coupe selon un axe BB' représenté en figure 8. Dans un souci de clarté de la figure, les épaisseurs des divers éléments ne sont pas représentées à l'échelle. Le circuit intégré 40 comprend de façon classique un substrat 41, une première couche 42 d'oxyde épais, par exemple d'une épaisseur de 0,35 micromètre, une couche de polysilicium gravé formant le fusible 20, par exemple d'une épaisseur de 0,2 micromètre, une couche d'oxyde gravé 43, une deuxième couche 44 d'oxyde épais et une couche de métallisation 45 dans laquelle sont gravés des conducteurs. Les contacts 5, 6, représentés en traits

pointillés, sont classiquement des orifices métallisés reliant le fusible à la couche 45 ou toute autre métallisation prévue à un niveau supérieur. L'oxyde gravé 43 forme des monticules, ou "espaceurs d'oxyde" 43-1, 43-2 recouvrant les flancs de la région centrale 2 et de la partie amincie 21. Enfin, le fusible 20 est recouvert d'une couche de siliciure 46 permettant de diminuer dans de fortes proportions sa résistance électrique, comme on l'a déjà indiqué.

[0043] Comme cela est bien connu de l'homme de l'art, les espaceurs 43-1, 43-2 ne sont pas nécessaires à la réalisation du fusible et doivent leur existence au fait que le fusible est réalisé collectivement avec d'autres éléments du circuit intégré 40, par exemple des transistors MOS (non représentés). Toutefois, la présence des espaceurs 43-1, 43-2 sur les flancs du fusible 20 a pour effet négatif de limiter l'étendue de la couche de siliciure 46.

[0044] Ici, l'avantage de l'invention réside dans le fait que l'efficacité du processus de gravure de l'oxyde 43 est améliorée dans les zones où la région centrale 2 se trouve à proximité des éléments factices 22, 23. Ce phénomène, bien connu de l'homme de l'art, est appelé "effet de charge localisé". Le résultat apparaît clairement lorsque l'on compare les espaceurs 43-1, 43-2 présents sur les flancs de la zone amincie 21 avec, par exemple, des espaceurs 43-3, 43-4 présents sur des flancs externes 22-2, 23-2 des éléments factices 22, 23. On voit que les espaceurs 43-3, 43-4 recouvrent presque entièrement les flancs externes des éléments factices 22, 23 alors que les espaceurs 43-1, 43-2 ne recouvrent que partiellement les flancs de la zone amincie 21.

[0045] En définitive, la présence des éléments factices 22, 23 favorise la gravure de l'oxyde 43 sur les flancs du fusible et permet d'obtenir une couche de siliciure 46 plus étendue. La couche de siliciure 46 étant plus étendue, la résistance électrique du fusible est plus faible que celle d'un fusible classique de même dimension. Cet avantage améliore le rapport courant/tension du fusible et se cumule avec les autres avantages de l'invention pour l'obtention d'un bon rendement de claquage et une fiabilité élevée.

[0046] Il apparaîtra clairement à l'homme de l'art que la présente invention est susceptible de diverses variantes et modes de réalisation, notamment en ce qui concerne la dimension et la forme du fusible, le rapport entre la longueur L et la largeur W1 de la région centrale 2, l'agencement de la zone amincie 21, la largeur W2 de la zone amincie 21, l'agencement du fusible au sein d'un circuit intégré, les matériaux et les technologies utilisés pour la réalisation du fusible...

[0047] De façon générale, la présente invention permet d'obtenir, à encombrement de fusible identique et dans des conditions standard de claquage, une densité de courant plus élevée et une énergie de claquage plus importante, et permet par ailleurs de maîtriser la localisation du point d'éclatement d'un fusible. La prévision d'éléments factices agencés comme décrit plus haut est

un aspect complémentaire de l'invention permettant de franchir les limites imposées par une technologie de fabrication.

[0048] En l'état actuel de la technologie, un fusible selon l'invention réalisé en polysilicium peut présenter une épaisseur de 0,2 micromètre pour une largeur moyenne de l'ordre de 0,25 micromètre, et un fusible réalisé en métal peut présenter une épaisseur de 0,5 micromètre pour une largeur de 0,4 micromètre.

#### Revendications

1. Procédé de réalisation par photolithographie de circuit intégré (40) disposant d'au moins un fusible (20) comprenant des plages (3,4) comportant des contacts électriques (5,6) et une région centrale (2) sensiblement en forme de barreau comportant une région amincie (21) formant un point faible facilitant le claquage du fusible par augmentation de la densité de courant ( $I_c$ ) dans des conditions standards ( $I_c$ ,  $V_c$ ) de claquage, caractérisé par des étapes consistant à :

- former un masque d'insolation reproduisant un dessin de fusible (D20) comportant la région centrale (D2) en forme de barreau, en disposant au moins un élément factice (D22) à proximité de la région centrale (D2), et
- former, par insolation à travers le masque d'insolation, un masque de gravure de fusible (20) dont la région centrale (2) fait apparaître une zone amincie (21) par effet optique de proximité, de sorte que la largeur ( $W_2$ ) de la zone amincie est inférieure à un minimum technologique ( $W_{min}$ ) déterminé par la technologie de fabrication du circuit intégré.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel chaque élément factice (D22,D23) a un bord (D22-1,D23-1) disposé, par rapport au bord correspondant de la région centrale (D2), à une distance ( $DE_3$ ) inférieure au seuil technologique ( $SE_{min}$ ) en dessous duquel se manifeste l'effet optique de proximité.
3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel la région centrale (D2) du dessin de fusible (D20) a une largeur ( $DW_1$ ) choisie pour obtenir une largeur ( $W_1$ ) de fusible (20) sensiblement égale au minimum technologique ( $W_{min}$ ), en dehors de la zone amincie.
4. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel la largeur ( $W_2$ ) de la zone amincie (21) est sensiblement égale à la moitié de la largeur moyenne ( $W_1$ ) de la région centrale (2) en dehors de la zone amincie.

5. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel l'effet optique de proximité forme un amincissement progressif de la région centrale (2).

6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 5, dans lequel l'effet optique de proximité forme, entre la région centrale (2) et la zone amincie (21), des transitions d'amincissement présentant des bords obliques.

7. Procédé selon l'une des revendications 1 à 6, dans lequel sur le dessin de fusible (D20), on dispose deux éléments factices (D22,D23) de part et d'autre de la région centrale (D2).

8. Procédé selon l'une des revendications 1 à 7, dans lequel il est prévu de former deux encoches (21-1,21-2) sur les flancs de la région centrale (2) du fusible (20).

9. Procédé selon l'une des revendications 1 à 8, dans lequel, en utilisant l'effet optique de proximité, le masque de gravure de fusible (20) présente au moins une ouverture de gravure de largeur ( $E_2$ ) supérieure à la largeur ( $DE_2$ ,  $DE_3$ ) d'espacement entre les éléments prévue sur le dessin (D20) de fusible du masque d'insolation.

10. Procédé selon l'une des revendications 1 à 9, dans lequel le masque de gravure (32) est obtenu par dépôt d'une couche de résine photosensible sur une couche (31) du circuit intégré, suivi d'une étape d'insolation de la résine par l'intermédiaire du masque d'insolation et d'une étape de retrait de la résine insolée au moyen d'un solvant.

11. Procédé selon l'une des revendications 1 à 10 dans lequel le fusible (20) de circuit intégré (40) est réalisé par gravure d'une couche mince de polysilicium, de métal ou d'alliage, ou encore par gravure d'une couche mince formée d'un empilement de métaux ou d'alliages.

12. Procédé selon l'une des revendications 1 à 11 dans lequel le fusible (20) de circuit intégré (40) est réalisé en polysilicium siliciuré (46).

13. Procédé selon l'une des revendications 1 à 12, comportant une étape de gravure au plasma.

14. Procédé selon l'une des revendications 1 à 13, dans lequel la disposition d'éléments factices (22,23) favorise la gravure d'une couche d'oxyde (43) sur les flancs du fusible (40), de sorte que le fusible présente des espaceurs d'oxyde (43-1,43-2) ne recouvrant pas entièrement les flancs de la zone amincie (2,21).

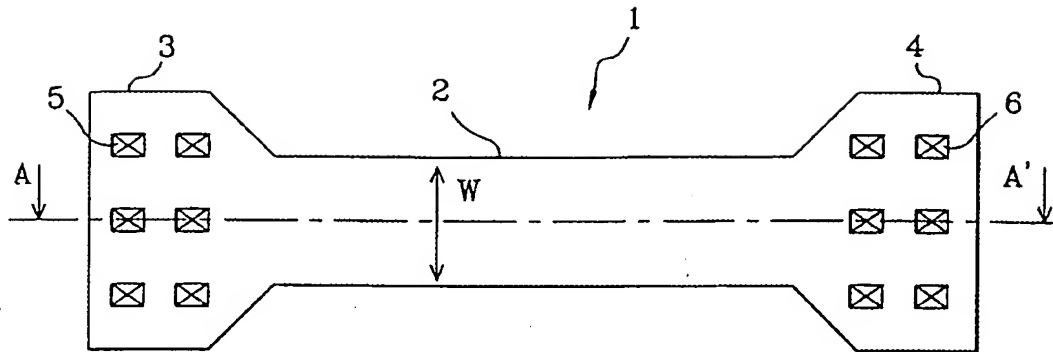


FIG.1

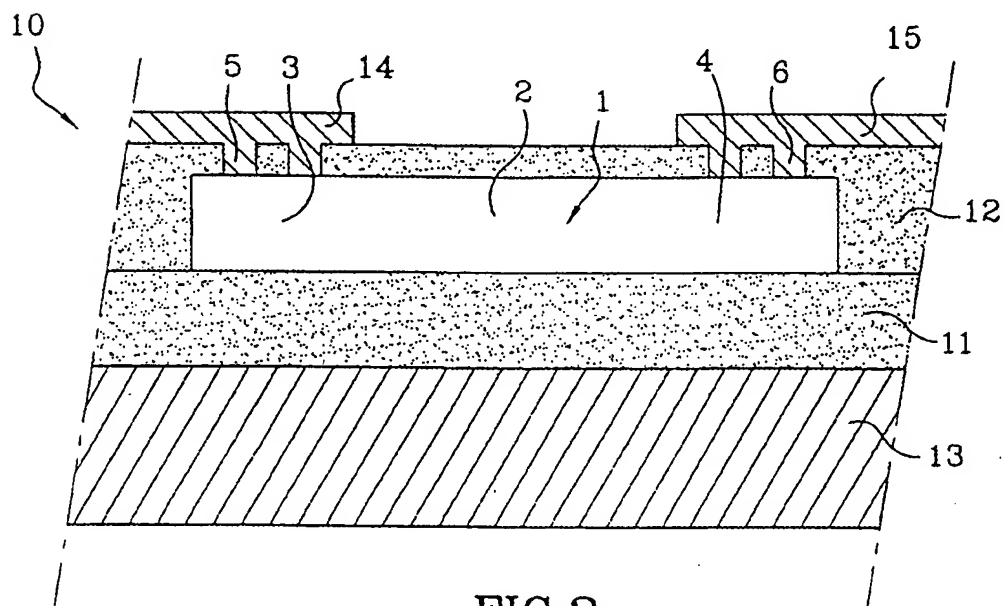
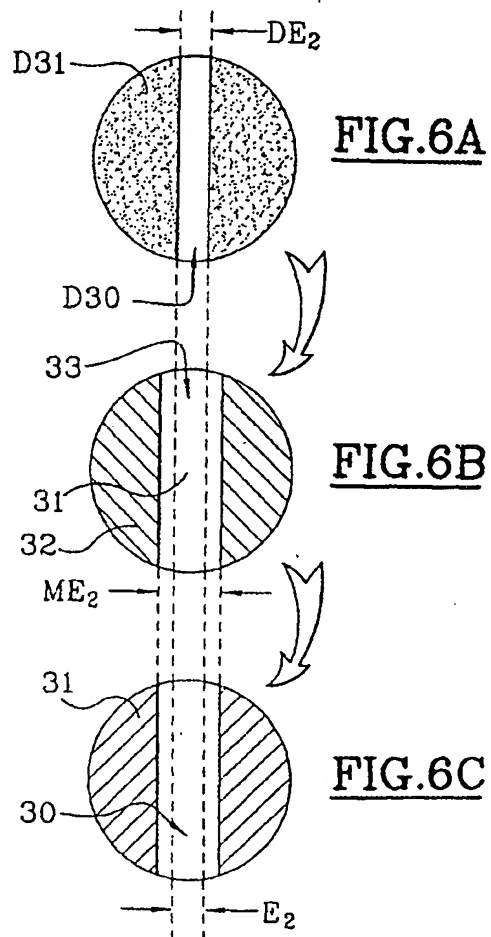
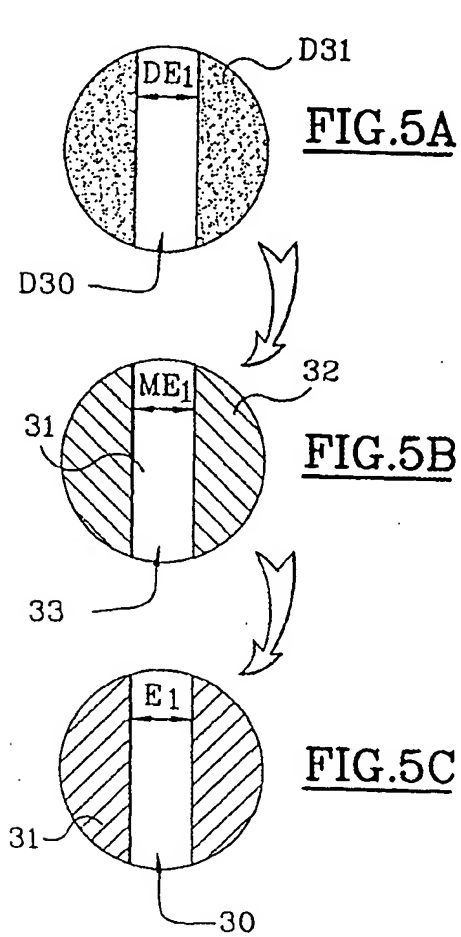
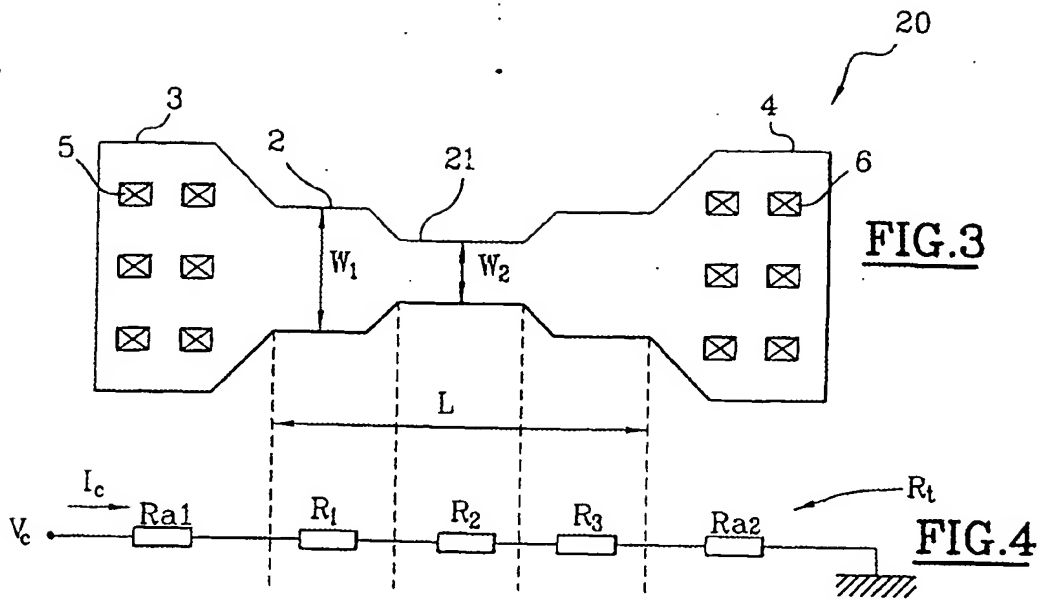
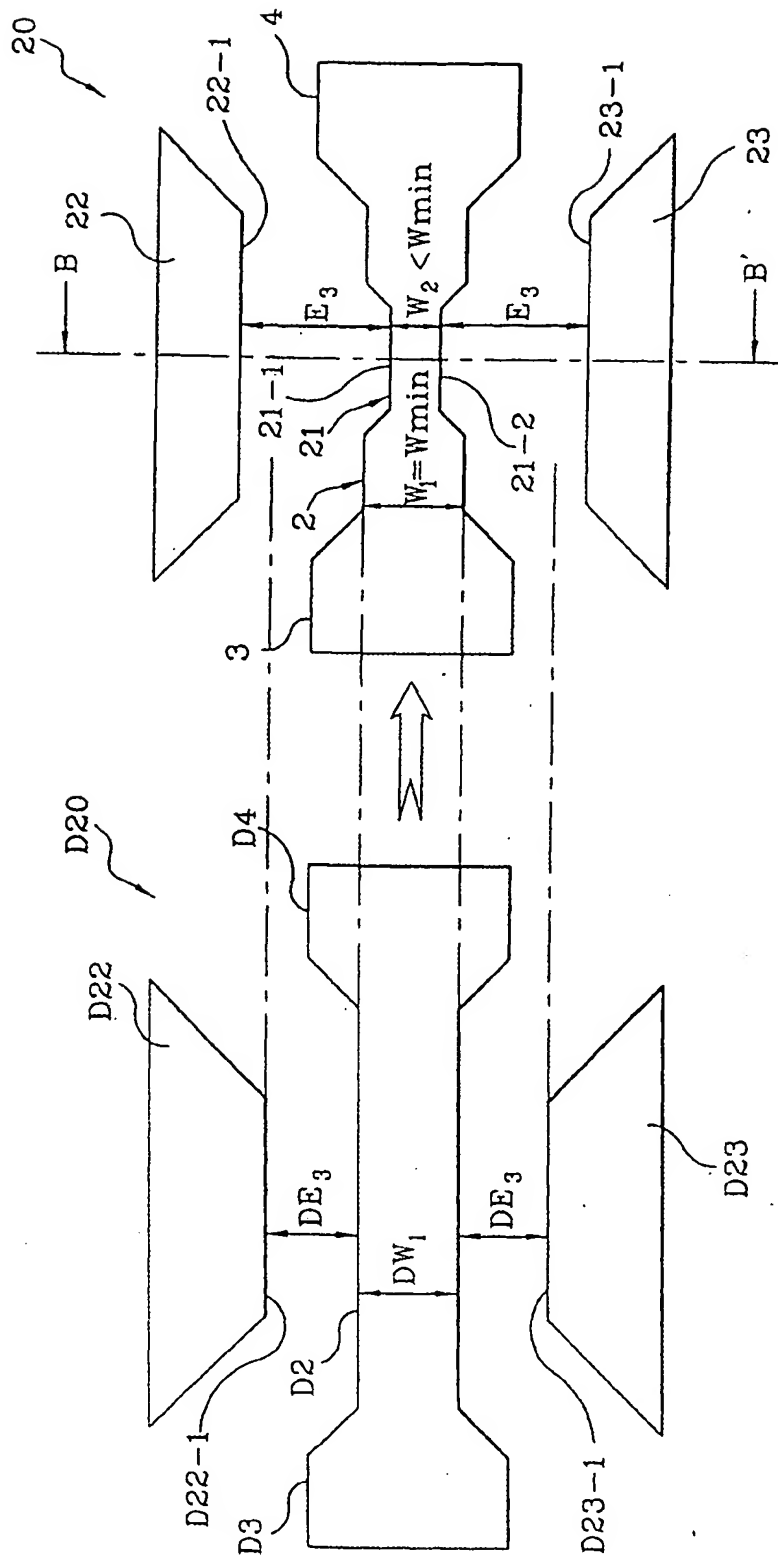
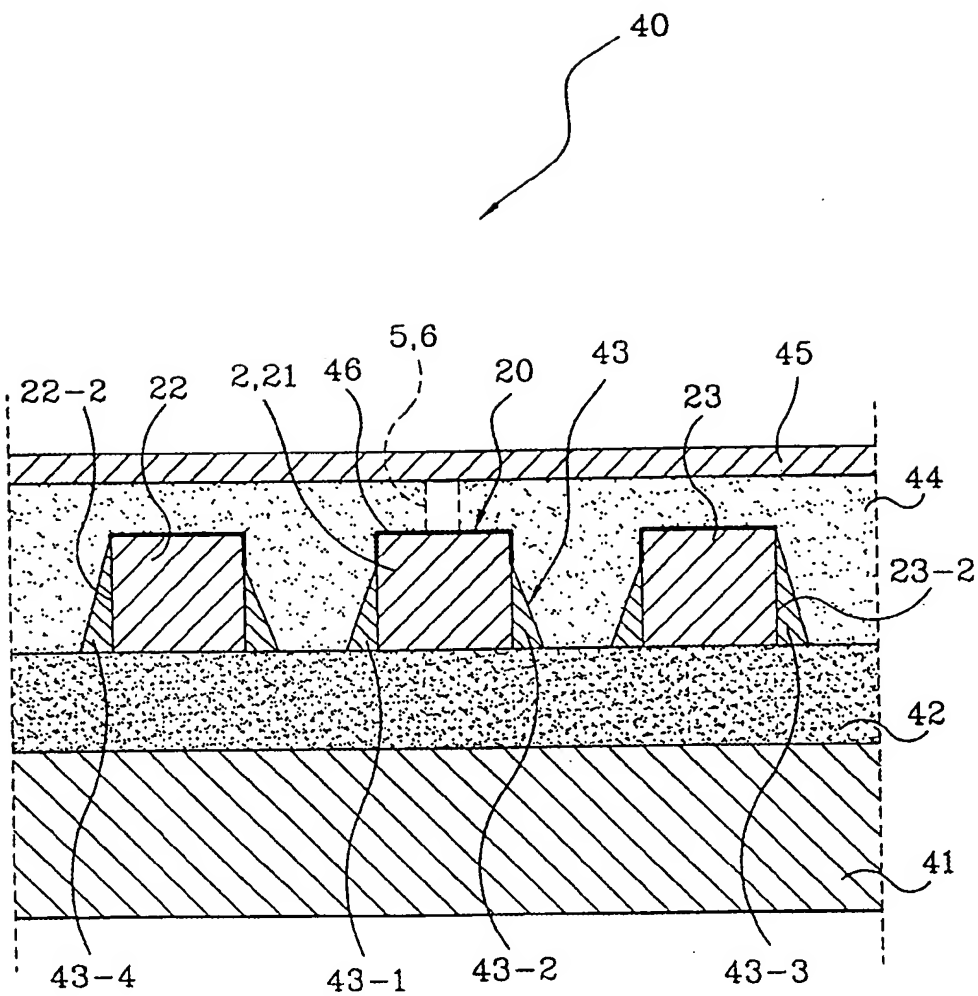


FIG.2







**FIG.9**

DERWENT-ACC-NO: 2001-572332

DERWENT-WEEK: 200612

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Method for implementation of integrated  
circuit fuse  
with localized breakdown point

INVENTOR: DELPECH, P; REVIL, N

PATENT-ASSIGNEE: STMICROELECTRONICS SA[SGSA]

PRIORITY-DATA: 1998FR-0006071 (May 14, 1998)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE
PAGES MAIN-IPC		
DE 69928673 E	January 5, 2006	N/A
000 G03F 007/20		
EP 1103858 A2	May 30, 2001	F
010 G03F 007/20		
EP 1103858 B1	November 30, 2005	F
000 G03F 007/20		

DESIGNATED-STATES: DE FR GB IT DE FR GB IT

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO
APPL-DATE		
DE 69928673E	N/A	1999DE-0628673
May 14, 1999		
DE 69928673E	N/A	2001EP-0104110
May 14, 1999		
DE 69928673E	Based on	EP 1103858
N/A		
EP 1103858A2	Div ex	1999EP-0401181
May 14, 1999		
EP 1103858A2	N/A	2001EP-0104110
May 14, 1999		
EP 1103858A2	Div ex	EP 957403
N/A		
EP 1103858B1	Div ex	1999EP-0401181
May 14, 1999		
EP 1103858B1	N/A	2001EP-0104110
May 14, 1999		
EP 1103858B1	Div ex	EP 957403

N/A

INT-CL (IPC): G03F007/20, H01L021/02 , H01L021/033 , H01L023/52 ,  
H01L023/525

RELATED-ACC-NO: 1999-613019

ABSTRACTED-PUB-NO: EP 1103858A

BASIC-ABSTRACT:

NOVELTY - The implementation by photolithography of integrated circuit includes at least one fuse (20) comprising pads (3,4) for electrical contacts and a central region (2) substantially in the form of a bar with a thinner region (21) forming a weak point facilitating the breakdown of fuse element by increasing current density in the conditions of standard breakdown. The method comprises the following steps: the formation of an exposition mask reproducing the fuse design (D20) comprising a central region (D2) in the form of a bar, and artificial elements (D22, D23) in the neighbourhood of central region; the formation of etching mask by exposition for the fuse (20) having the central region (2) with the appearance of a thinner region (21) by the optical effect of proximity, so that the width (W2) of thin region is less than the technological minimum (Wmin) determined by the manufacturing method for integrated circuit.

DETAILED DESCRIPTION - Each artificial element (D22, D23) has an edge (D22-1, D23-1) located with respect to the central region (D2) at a distance (DE3), which is less than the technological threshold (SEmin), below which the optical effect of proximity is manifested. The central region (D2) has a width (DW1) chosen so to obtain the width (W1) of fuse (20) substantially equal to the technological minimum (Wmin). The width (W2) of thin region is substantially equal to half the average width (W1) of central region on the outside

of thin  
zone. The optical effect of proximity forms a progressive thinning  
of central  
region, and also transitions of thinning with oblique edges. The  
thinning is  
by the formation of notches (21-1, 21-2) on the sides of central  
region. The  
etching mask has at least one opening greater than the spacing  
between elements  
in the fuse design exposition mask. The etching mask is obtained by  
the  
deposition of a layer of photosensitive resin onto a layer of  
integrated  
circuit, following an exposition step and a step for the resin  
removal by a  
solvent. The fuse of integrated circuit is implemented by the  
etching of a  
thin layer of polysilicon, metal or alloy, or by etching of a thin  
layer formed  
by a pile of metals or alloys. The fuse of integrated circuit is  
implemented  
by polysilicon silicide, with a metal as eg. titanium, cobalt,  
tungsten,  
tantalum, and the method includes a step of etching in plasma. The  
implementation of artificial elements (22,23) favours the etching of  
an oxide  
layer on the sides of fuse, so that the fuse has oxide spacers which  
do not  
cover entirely the sides of thin zone.

USE - In integrated circuits (ICs), and in particular in fuses for  
integrated  
circuits; eg. for the protection of gates of MOS transistors from  
the  
accumulation of electrostatic charges in the production of integrated  
circuits,  
and for the disconnection of defective or initially redundant word or  
bit lines  
in large-capacity memory integrated circuits.

ADVANTAGE - The proposed fuse is susceptible to easier breakdown than  
the  
standard fuse, with the same dimensions and at the same current; also  
the  
proposed fuse has higher breakdown output and higher reliability.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The drawing is a plan view of the initial  
design  
and the implemented fuse.

Central region 2,D2

Pads 3,4,D3,D4

Fuse 20,D20

Thin region 21

Notches forming thin region 21-1, 21-2

Artificial elements 22,23,D22,D23

Edges of artificial elements 22-1, 23-1, D22-1, D23-1

CHOSEN-DRAWING: Dwg.7,

TITLE-TERMS: METHOD IMPLEMENT INTEGRATE CIRCUIT FUSE LOCALISE  
BREAKDOWN POINT

DERWENT-CLASS: P84 U11

EPI-CODES: U11-D03B;

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N2001-426617